	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN003	文件编号	XS-W-003
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	16-B1-05
		页码	1/2

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W2XN003 芯片封装的成品管主要用于 VHF 中作本振及电话机电路。

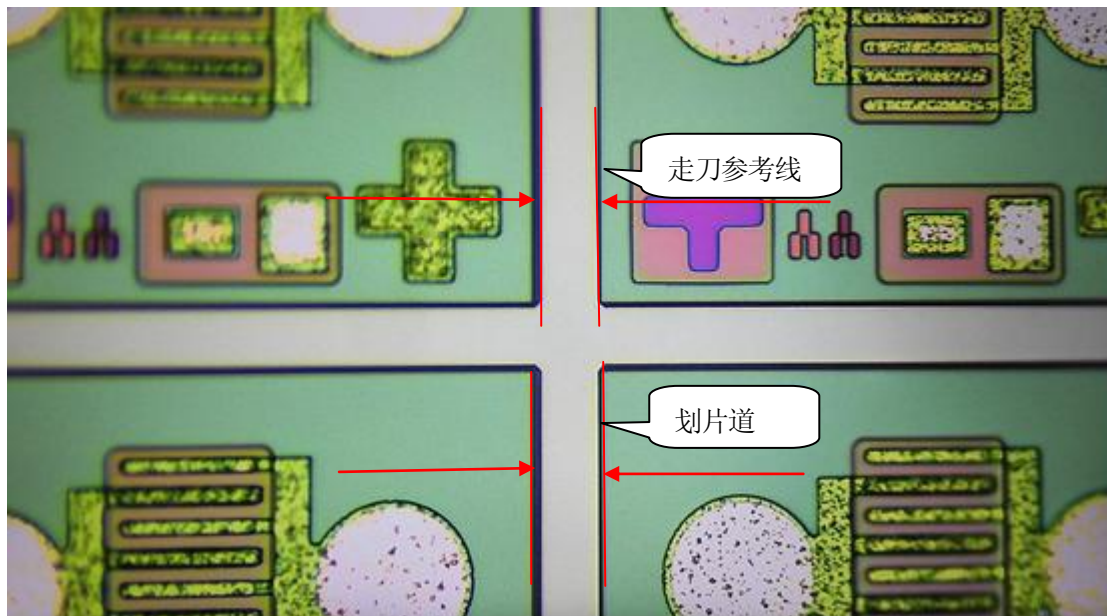
1.2 特点

- 特征频率高
- 反向漏电小

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸 (mm×mm)	0.32×0.26		
	芯片厚度 (μm)	170±20		
	划片道*尺寸 (μm)	40		
	键合区面积 (μm ²)	基区	φ66	
		发射区	φ66	
	钝化层	Si ₃ N ₄		
	正面电极金属	金属	铝	
		厚度(μm)	1.4±0.3	
	背面电极金属(表层)	金	银	
	装片要求(推荐)	共晶	低温共晶	
	硅片直径 (mm)	φ125		
键合要求(推荐)	金丝: φ20μm; E、B区各一根			

* 划片道位置示意图:




备注: 划片道两侧的铝条不断裂即判为合格。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市滨江中路 275 号
电话: (0510) 86851182 86852109

网址: <http://www.xinshun.cn>
传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W2XN003	文件编号	XS-W-003
	高频放大环境额定双极型晶体管	版本号	16-B1-05
		页码	2/2

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位	备注
集电极-基极电压	V_{CB0}	25	V	推荐封装形式: T0-92 推荐成品型号: 3DG9018
集电极-发射极电压	V_{CE0}	18	V	
发射极-基极电压	V_{EB0}	5	V	
集电极电流	I_C	50	mA	
耗散功率($T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	0.3	W	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
集电极-基极截止电流	I_{CB0}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$			0.1	μA
发射极-基极截止电流	I_{EB0}	$V_{EB}=3.5\text{V}, I_C=0$			0.1	μA
共发射极正向电流传输比的静态值	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	28		198	
集电极-发射极饱和电压	V_{CEsat}	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$			0.5	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=5\text{mA}$ $f=400\text{MHZ}$	600			MHz

注意事项:

- 芯片存储条件(推荐): 氮气保护, 温度 $25\pm 5^{\circ}\text{C}$, 湿度 $\leq 45\%$;
- 本产品说明书仅供参考, 不作为合同的一部分, 具体以双方签订的技术协议为准;
- 本产品说明书如有版本变更, 恕不另行告知! 客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新;
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能, 买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施, 以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地址: 江苏省江阴市滨江中路 275 号
 电话: (0510) 86851182 86852109

网址: <http://www.xinshun.cn>
 传真: (0510) 86851532